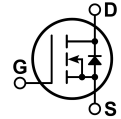


N-Channel FREDFET


POWER MOS 8® is a high speed, high voltage N-channel switch-mode power MOSFET. This 'FREDFET' version has a drain-source (body) diode that has been optimized for high reliability in ZVS phase shifted bridge and other circuits through reduced t_{rr} , soft recovery, and high recovery dv/dt capability. Low gate charge, high gain, and a greatly reduced ratio of C_{rSS}/C_{iSS} result in excellent noise immunity and low switching loss. The intrinsic gate resistance and capacitance of the poly-silicon gate structure help control di/dt during switching, resulting in low EMI and reliable paralleling, even when switching at very high frequency.


 ISOTOP™
APT17F120J

Single die FREDFET



FEATURES

- Fast switching with low EMI
- Low t_{rr} for high reliability
- Ultra low C_{rSS} for improved noise immunity
- Low gate charge
- Avalanche energy rated
- RoHS compliant 

TYPICAL APPLICATIONS

- ZVS phase shifted and other full full bridge
- Half bridge
- PFC and other boost converter
- Buck converter
- Single and two switch forward
- Flyback

Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Ratings	Unit
I_D	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ C$	18	A
	Continuous Drain Current @ $T_C = 100^\circ C$	12	
I_{DM}	Pulsed Drain Current ^①	104	
V_{GS}	Gate-Source Voltage	±30	V
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy ^②	2165	mJ
I_{AR}	Avalanche Current, Repetitive or Non-Repetitive	14	A

Thermal and Mechanical Characteristics

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
P_D	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ C$			545	W
$R_{\theta JC}$	Junction to Case Thermal Resistance			0.23	$^\circ C/W$
$R_{\theta CS}$	Case to Sink Thermal Resistance, Flat, Greased Surface		0.15		
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55		150	$^\circ C$
$V_{Isolation}$	RMS Voltage (50-60Hz Sinusoidal Waveform from Terminals to Mounting Base for 1 Min.)	2500			V
W_T	Package Weight		1.03		oz
			29.2		g
Torque	Terminals and Mounting Screws.			10	in·lbf
				1.1	N·m

Static Characteristics
T_J = 25°C unless otherwise specified
APT17F120J

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
V _{BR(DSS)}	Drain-Source Breakdown Voltage	V _{GS} = 0V, I _D = 250μA	1200			V
ΔV _{BR(DSS)}/ΔT_J}	Breakdown Voltage Temperature Coefficient	Reference to 25°C, I _D = 250μA		1.41		V/°C
R _{DS(on)}	Drain-Source On Resistance ^③	V _{GS} = 10V, I _D = 14A		0.55	0.58	Ω
V _{GS(th)}	Gate-Source Threshold Voltage	V _{GS} = V _{DS} , I _D = 2.5mA	2.5	4	5	V
ΔV _{GS(th)}/ΔT_J}	Threshold Voltage Temperature Coefficient			-10		mV/°C
I _{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	V _{DS} = 1200V V _{GS} = 0V			250 1000	μA
I _{GSS}	Gate-Source Leakage Current	V _{GS} = ±30V			±100	nA

Dynamic Characteristics
T_J = 25°C unless otherwise specified

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
g _{fs}	Forward Transconductance	V _{DS} = 50V, I _D = 14A		31		S
C _{iss}	Input Capacitance	V _{GS} = 0V, V _{DS} = 25V f = 1MHz		9670		pF
C _{rss}	Reverse Transfer Capacitance			115		
C _{oss}	Output Capacitance			715		
C _{o(cr)} ^④	Effective Output Capacitance, Charge Related	V _{GS} = 0V, V _{DS} = 0V to 800V		275		pF
C _{o(er)} ^⑤	Effective Output Capacitance, Energy Related			140		
Q _g	Total Gate Charge	V _{GS} = 0 to 10V, I _D = 14A, V _{DS} = 600V		300		nC
Q _{gs}	Gate-Source Charge			50		
Q _{gd}	Gate-Drain Charge			140		
t _{d(on)}	Turn-On Delay Time	Resistive Switching V _{DD} = 800V, I _D = 14A R _G = 2.2Ω ^⑥ , V _{GG} = 15V		50		ns
t _r	Current Rise Time			31		
t _{d(off)}	Turn-Off Delay Time			170		
t _f	Current Fall Time			48		

Source-Drain Diode Characteristics

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I _S	Continuous Source Current (Body Diode)	MOSFET symbol showing the integral reverse p-n junction diode (body diode)			18	A
I _{SM}	Pulsed Source Current (Body Diode) ^①				104	
V _{SD}	Diode Forward Voltage	I _{SD} = 14A, T _J = 25°C, V _{GS} = 0V			1.2	V
t _{rr}	Reverse Recovery Time	I _{SD} = 14A ^③ di _{SD} /dt = 100A/μs	T _J = 25°C		330	ns
			T _J = 125°C		660	
Q _{rr}	Reverse Recovery Charge		T _J = 25°C		1.72	μC
			T _J = 125°C		4.67	
I _{rrm}	Reverse Recovery Current	T _J = 25°C		11	A	
		T _J = 125°C		16		
dv/dt	Peak Recovery dv/dt	I _{SD} ≤ 14A, di/dt ≤ 1000A/μs, V _{DD} = 100V, T _J = 125°C			25	V/ns

① Repetitive Rating: Pulse width and case temperature limited by maximum junction temperature.

② Starting at T_J = 25°C, L = 22.1mH, R_G = 25Ω, I_{AS} = 14A.

③ Pulse test: Pulse Width < 380μs, duty cycle < 2%.

④ C_{o(cr)} is defined as a fixed capacitance with the same stored charge as C_{oss} with V_{DS} = 67% of V_{(BR)DSS}.

⑤ C_{o(er)} is defined as a fixed capacitance with the same stored energy as C_{oss} with V_{DS} = 67% of V_{(BR)DSS}. To calculate C_{o(er)} for any value of V_{DS} less than V_{(BR)DSS}, use this equation: C_{o(er)} = -8.27E-7/V_{DS}² + 1.01E-7/V_{DS} + 1.43E-10.

⑥ R_G is external gate resistance, not including internal gate resistance or gate driver impedance. (MIC4452)

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

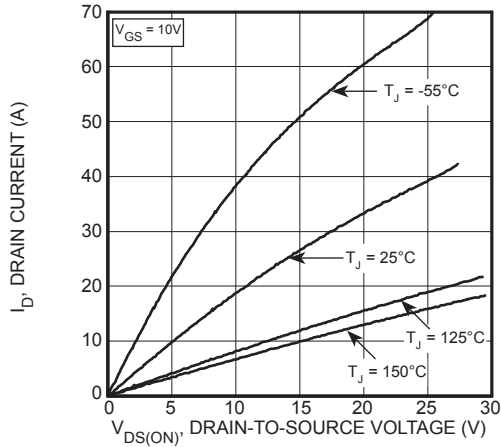


Figure 1, Output Characteristics

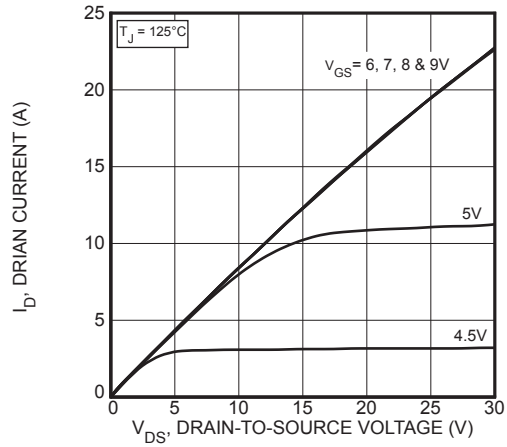


Figure 2, Output Characteristics

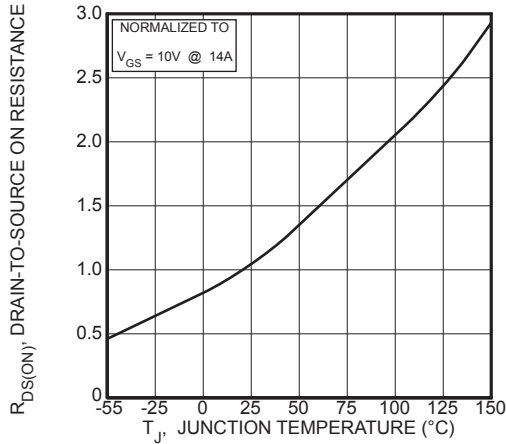


Figure 3, $R_{DS(ON)}$ vs Junction Temperature

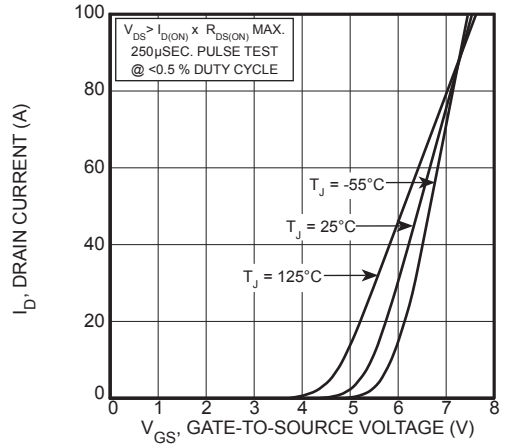


Figure 4, Transfer Characteristics

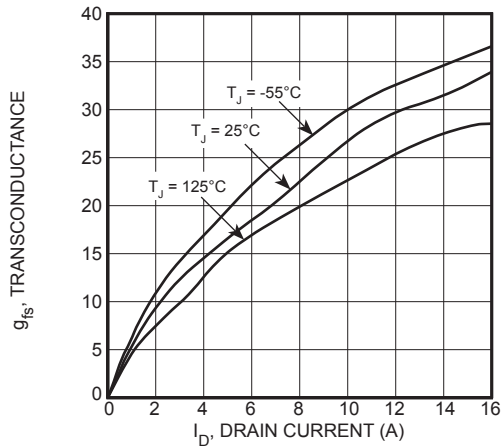


Figure 5, Gain vs Drain Current

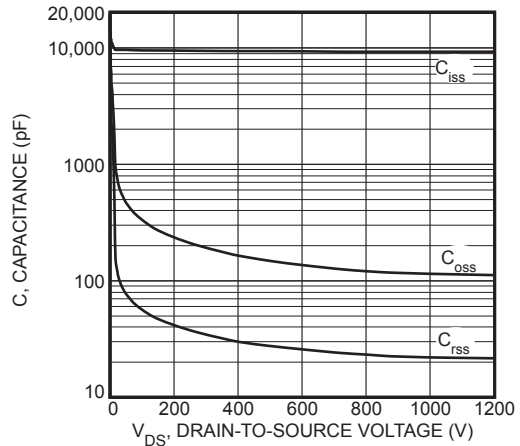


Figure 6, Capacitance vs Drain-to-Source Voltage

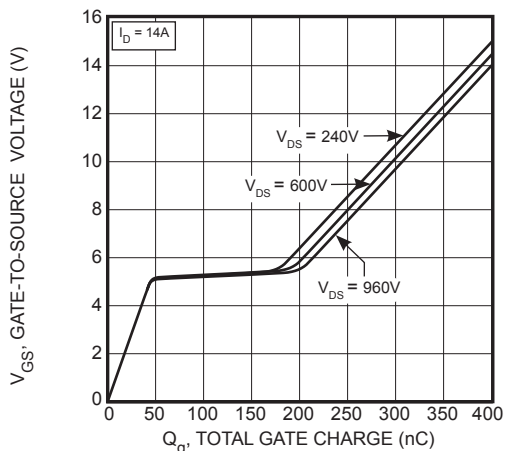


Figure 7, Gate Charge vs Gate-to-Source Voltage

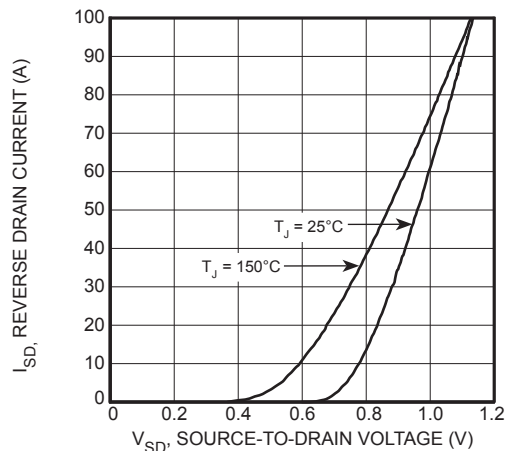
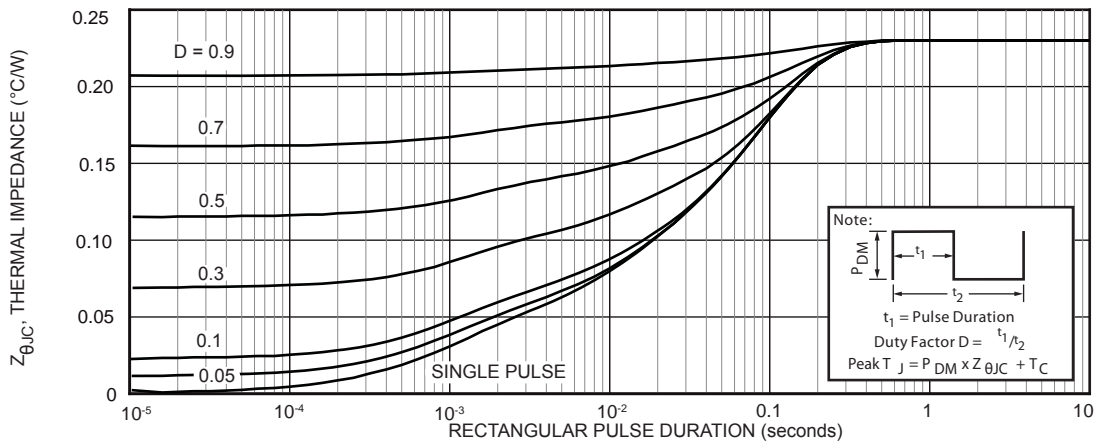
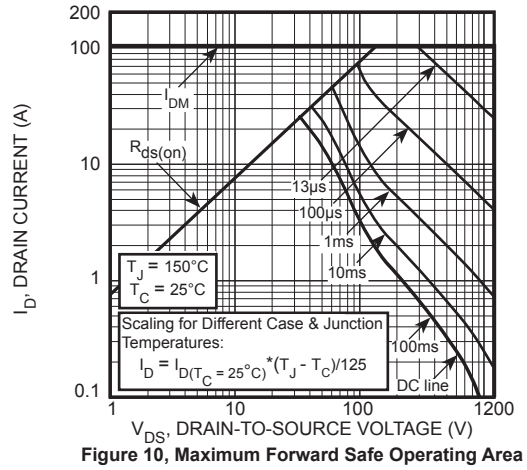
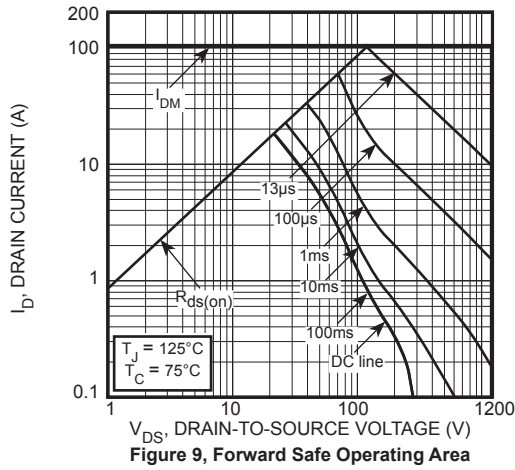
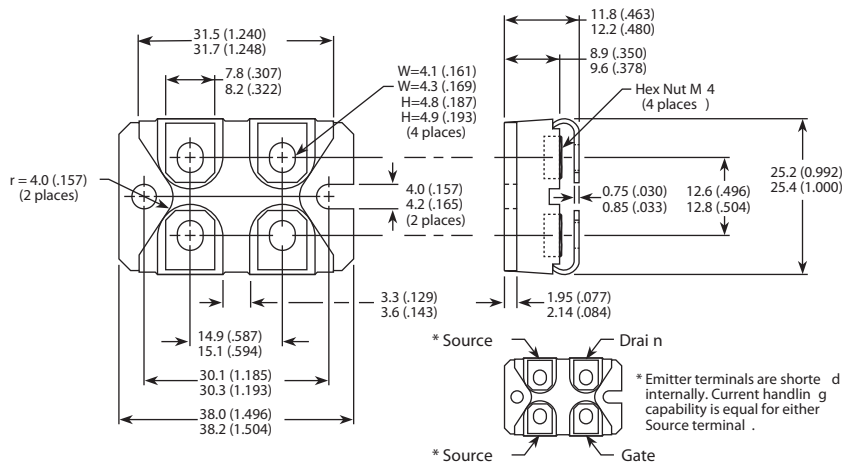


Figure 8, Reverse Drain Current vs Source-to-Drain Voltage



SOT-227 (ISOTOP®) Package Outline



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А